

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

51

Int. Cl. 2:

H 01 L 29/91

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

DE 27 33 840 A 1

11

Offenlegungsschrift 27 33 840

21

Aktenzeichen: P 27 33 840.5

22

Anmeldetag: 27. 7. 77

43

Offenlegungstag: 16. 2. 78

30

Unionspriorität:

32 33 31

9. 8. 76 Großbritannien 33044-76

54

Bezeichnung: Halbleiteranordnung mit einem gleichrichtenden Metall-Halbleiter-Übergang

71

Anmelder: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Niederlande)

74

Vertreter: David, G.M., Pat.-Ass., 2000 Hamburg

72

Erfinder: Shannon, John Martin, Salfords, Redhill, Surrey (Großbritannien)

DE 27 33 840 A 1

PATENTANSPRUCHE:

1. Halbleiteranordnung mit einem gleichrichtenden Metall-Halbleiter-Hochspannungsübergang, die einen Halbleiterkörper enthält, der eine Halbleiterschicht vom ersten Leitungstyp, die an eine Oberfläche des Körpers grenzt, eine Metallschicht, die sich in Kontakt mit einem Teil der genannten Oberfläche erstreckt und dort einen gleichrichtenden Übergang mit der Schicht vom ersten Leitungstyp bildet, und einen niederohmigen, nicht gleichrichtenden Kontakt mit der Schicht vom ersten Leitungstyp enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht vom ersten Leitungstyp eine erste und eine zweite Teilschicht enthält, von denen die erste Teilschicht an der genannten Oberfläche des Körpers angrenzt und eine Dotierung aufweist, die von der zweiten Teilschicht, auf der sie sich befindet, verschieden ist, wobei eine Anzahl isolierter diskreter Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp sich in der Nähe der Grenze zwischen der ersten und der zweiten Teilschicht und wenigstens unter dem durch die Metallschicht kontaktierten Oberflächenteil befindet.

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens unter dem durch die Metallschicht kontaktierten Oberflächenteil die diskreten Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp sich auf einer

809807/0576

ORIGINAL INSPECTED

nahezu gleichmässigen Tiefe von der genannten Oberfläche her befinden.

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Teilschicht eine höhere Dotierung als die zweite Teilschicht aufweist.

4. Halbleiteranordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die isolierten diskreten Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp einen nahezu gleichmässigen gegenseitigen Abstand aufweisen, und dass der Abstand zwischen angrenzenden Rändern zweier nebeneinander liegender Gebiete höchstens gleich dem Zweifachen der Dicke der ersten Teilschicht vom ersten Leitungstyp ist.

5. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Teilschicht eine niedrigere Dotierung als die zweite Teilschicht aufweist, auf der sie sich befindet.

6. Halbleiteranordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die isolierten diskreten Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp einen nahezu gleichmässigen gegenseitigen Abstand aufweisen, und dass der Abstand zwischen angrenzenden Rändern zweier nebeneinander liegender Gebiete grösser als das Zweifache der Dicke der ersten Teilschicht vom ersten Leitungstyp ist.

809807/0576

7. Halbleiteranordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der Schicht vom ersten Leitungstyp ein an die Oberfläche grenzendes Gebiet vom entgegengesetzten Leitungstyp rings um den Umfang des durch die Metallschicht kontaktierten Oberflächenteiles vorhanden ist, wobei sich diese Metallschicht in Kontakt mit dem genannten Gebiet vom entgegengesetzten Leitungstyp erstreckt.

8. Halbleiteranordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass weitere an die Oberfläche grenzende Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp vorhanden sind, die sich als Bänder rings um den durch die Metallschicht kontaktierten Oberflächenteil erstrecken.

9. Halbleiteranordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht vom ersten Leitungstyp als eine epitaktische Schicht vorhanden ist, die auf einem höher dotierten Substrat vom genannten ersten Leitungstyp abgelagert ist.

809807/0576

-2
4

HB. 32553
Va/AvdV
29.6.77

2733840

N.Y. Patent Office

"Halbleiteranordnung mit einem gleichrichtenden
Metall-Halbleiter-Übergang"

Die Erfindung bezieht sich auf eine
Halbleiteranordnung mit einem gleichrichtenden
Metall-Halbleiter-Hochspannungsübergang, die einen
Halbleiterkörper enthält, der eine Halbleiterschicht
vom ersten Leitungstyp, die an eine Oberfläche
des Körpers grenzt, eine Metallschicht, die sich
in Kontakt mit einem Teil der genannten Oberfläche
erstreckt und dort einen gleichrichtenden Übergang

5

809807/0576

2733840

mit der Schicht vom ersten Leitungstyp bildet, und einen niederohmigen, nicht gleichrichtenden Kontakt mit der Schicht vom ersten Leitungstyp enthält.

5 Gleichrichtende Metall-Halbleiter-Übergänge, die meistens als Schottky-Übergänge bezeichnet werden, werden häufig in der Halbleitertechnologie z.B. in Dioden für Schaltzwecke verwendet, in denen eine hohe Schaltgeschwindigkeit erforderlich ist. Eine hohe Schaltgeschwindigkeit in einem Schottky-Übergang wird 10 u.a. erhalten infolge der Tatsache, dass die Wirkung auf dem Transport von Majoritätsladungsträgern basiert und die gespeicherte Ladung in einem Schottky-Übergang gering, insbesondere viel geringer als in einem pn-Übergang ist. Die Durchlassspannung bei niedrigem Strom 15 eines Schottky-Übergangs ist niedrig im Vergleich zu der eines pn-Übergangs. Dioden mit Schottky-Übergängen weisen jedoch den Nachteil auf, dass in der Sperrichtung der Strom mit der angelegten Spannung schnell zunimmt und dass wegen der grossen Oberflächenfeldabhängigkeit 20 des Sperrstroms die Sperrkennlinie eines Schottky-Übergangs gleichmässig im Vergleich zu der einer diffundierten Diode mit pn-Übergang ist. Ausserdem weisen Schottky-Dioden in der Regel einen grösseren Leckstrom auf. Aus diesem Grunde ist die Anwendung 25 von Schottky-Dioden als Hochspannungsgleichrichter

809807/0576

2733840

beschränkt. Man hat schon längst gefunden, dass, wenn
die Sperrkennlinien einer Schottky-Diode wesentlich
verbessert werden können, die Schottky-Diode mit ihrer
inhärenten Majoritätsladungstransportmechanismus und
ihrem inhärenten niedrigen Durchlassspannungsabfall
5 ausser als Schalter für hohe Geschwindigkeiten auch
als ein Hochleistungsgleichrichter verwendet werden kann.
So wurden verschiedene Versuche gemacht um die Kennlinien
einer Schottky-Diode zu verbessern. Bisher wurde bei
10 diesen Versuchen davon ausgegangen, dass die gleich-
mässige Sperrkennlinie eines üblichen Schottky-Übergangs
an erster Stelle einem Randeffect am Umfang des Metall-
Halbleiter-Kontakts zuzuschreiben ist, wo eine hohe
Feldkonzentration zu einem ausserordentlich grossen
15 Leckstrom und einer niedrigen Sperrdurchschlagsspannung
führt. Daher wurden verschiedene Strukturen zur
Beschränkung dieses Randeffects vorgeschlagen und
dabei wird im allgemeinen von der Bildung eines so-
genannten Schutzringes ausgegangen, der durch ein an
20 die Oberfläche grenzendes Gebiet gebildet wird,
dessen Leitungstyp dem des Haupthalbleiterkörpers,
auf dem der Schottky-Übergang gebildet wird, entgegen-
gesetzt ist, wobei sich dieser Schutzring ringsum den
Umfang des Metall-Halbleiter-Kontakts erstreckt und
25 durch die den Schottky-Übergang bildende Metallschicht

809807/0578

7

PHB. 32553
29.6.77

2733840

5 kontaktiert wird. In vielen dieser Strukturen ist die
Metallschicht in Kontakt mit der Halbleiteroberfläche
in einer Öffnung in einer Isolierschicht auf der
Halbleiteroberfläche, wobei die Metallschicht einen
Randteil aufweist, der sich über einen kleinen Abstand
oberhalb des Randes der Isolierschicht rings um die
Öffnung erstreckt, und wobei der Schutzring nicht nur
an der Oberfläche am Rande der Öffnung kontaktiert wird,
sondern auch von dem Randteil der Metallschicht bedeckt
10 wird, die gegen diesen Schutzring durch die Isolierschicht
isoliert ist, wodurch eine MIS-Struktur gebildet wird.
Es wurde gefunden, dass durch die Bildung diffundierter
Schutzringstrukturen die Sperrkennlinien von Schottky-
Dioden erheblich verbessert werden, aber der Nachteil
15 ergibt sich, dass der Schutzring einen gleichrichtenden
pn-Übergang mit der gleichen Polarität wie die Schottky-
Sperre bildet und dass unter Vorspannungsbedingungen
ein genügender Strom über den Schutzringübergang fließen
kann, um zu bewirken, dass eine erhebliche Injektion
20 von Minoritätsladungsträgern in die Masse des Haupt-
halbleiterkörpers unter der Schottky-Sperre stattfindet.
Durch eine solche Injektion von Minoritätsladungsträgern
kann die Erholungszeit ungünstig beeinflusst werden.
Bei gewissen anderen Anordnungen wird das an die
25 Ob rfläche grenzende Gebiet vom entgegengesetzten

809807/0576

2733840

Leitungstyp fortgelassen und wird der Schutz auf zweckmässige Weise nur durch die MIS-Struktur gebildet, die aus dem Randteil der Metallkontaktschicht besteht, der sich über die Isolierschicht am Rande der Öffnung in der Isolierschicht erstreckt.

Sogar bei der Anordnung der beschriebenen Schutzringstrukturen und/oder der erweiterten Metallkontakt-MIS-Strukturen bleibt die Verbesserung in bezug auf die Sperrdurchschlagsspannung noch hinter der Verbesserung zurück, die bei Hochspannungs-pn-Übergangsdiodengleichrichtern erhalten werden kann. Ausserdem ist bei all diesen Strukturen der Sperrstrom noch immer von der Grösse des Oberflächenfeldes in der Nähe des Hauptteiles des Schottky-Übergangs abhängig und nimmt mit der angelegten Vorspannung zu, was zu höheren Leckströmen im Vergleich zu pn-Übergangsdioden führt.

Nach der Erfindung ist eine Halbleiteranordnung anfangs erwähnter Art dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht vom ersten Leitungstyp eine erste und eine zweite Teilschicht enthält, von denen die erste Teilschicht an der genannten Oberfläche des Körpers angrenzt und eine Dotierung aufweist, die von der der zweiten Teilschicht, auf der sie sich befindet, verschieden ist, wobei eine Anzahl isolierter diskreter Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp sich in der Nähe

809807/0576

2733840

der Grenze zwischen der ersten und der zweiten Teilschicht und wenigstens unter dem durch eine Metallschicht kontaktierten Oberflächenteil befindet.

Bei einer derartigen Anordnung wird ein
5 gleichrichtender Metall-Halbleiter-Übergang (als Schottky-Übergang bezeichnet) gebildet, in dem durch passende Wahl der unterschiedlichen A_p -messungen die Durchlasskennlinien eines üblichen Schottky-Übergangs aufrechterhalten werden können, während die Sperrkennlinien
10 erheblich verbessert werden und insbesondere der Sperrleckstrom niedrig ist. Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass die isolierten diskreten Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp bei einer sich mit der Zeit ändernden angelegten Sperrspannung
15 derart wirken, dass das Oberflächenfeld auf einen bestimmten Wert beschränkt wird, der von der angelegten Vorspannung unabhängig ist. Ausserdem können in gewissen Strukturen die genannten Gebiete, ohne dass für diesen Zweck andere besondere Massnahmen getroffen
20 werden, derart wirken, dass sich das Erschöpfungsgebiet an der Oberfläche ausbreitet und dass das elektrische Feld am Umfang des Schottky-Übergangs herabgesetzt wird.

Die Wirkung der Anordnung nach der Erfindung basiert, wie nachstehend im Detail beschrieben wird,
25 auf der Speicherung von Ladung in den isolierten

809807/0576

~~10~~
10

PHB.32553
29.6.77

2733840

diskreten Gebieten beim Anlegen einer Sperrspannung
über dem Schottky-Übergang, wobei dieser Ladungs-
speichereffekt auftritt, wenn die Sperrspannung einen
gewissen Wert erreicht, und wobei dieser Effekt dazu
5 dient, das Oberflächenfeld bei weiter zunehmender
Sperrspannung auf einen bestimmten Wert zu beschränken.
Es wird dafür gesorgt, dass das Vorhandensein der
isolierten diskreten Gebiete keinen wesentlichen
Effekt auf den Leitungsmechanismus der Anordnung
10 bei in der Durchlassrichtung vorgespanntem Übergang
ausübt. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, dass
die gespeicherte Ladung leicht abgeführt werden kann,
wenn die angelegte Spannung von der Sperr- in der
Durchlassrichtung geschaltet wird, und dass überdies
15 die insgesamt beim Anlegen der Sperrspannung gespeicherte
Ladung derart ist, dass die Erschöpfungsgebiete, die
zu den pn-Übergängen zwischen den aufgeladenen Gebieten
und der Schicht gehören, nicht genügend sind, um Leitungs-
wege über die Schicht vom ersten Leitungstyp, die sich
20 zwischen den isolierten diskreten Gebieten erstrecken,
zu sperren, wenn die angelegte Spannung zu der
Durchlassrichtung geschaltet wird.

Der Mechanismus zum Aufladen der isolierten
diskreten Gebiete und zur Beschränkung des Oberflächen-
25 felds basiert auf der anfänglichen Zunahme der

809807/0578

2733840

Sperrvorspannung, wodurch bewirkt wird, dass sich das Erschöpfungsgebiet des Schottky-Übergangs zu den isolierten diskreten Gebieten bei einer entsprechenden Zunahme des Oberflächenfeldes erstreckt.

5 Schliesslich erreicht das Erschöpfungsgebiet die isolierten diskreten Gebiete und tritt Durchgriff (punch-through) zu den schwebenden pn-Übergängen zwischen den genannten Gebieten und der Schicht vom ersten Leitungstyp auf. Vorausgesetzt, dass die
10 isolierten diskreten Gebiete einen geeigneten gegenseitigen Abstand aufweisen, wird das Oberflächenfeld nun auf einen bestimmten Wert beschränkt infolge der Tatsache, dass bei weiter zunehmender Sperrspannung die diskreten Gebiete aufgeladen werden, wenn die
15 zusätzliche Spannung oberhalb der Durchgriffsspannung über den genannten pn-Übergängen herabgesetzt wird. Die Dotierung der Schicht und die Abmessungen und der gegenseitige Abstand der isolierten diskreten Gebiete werden entsprechend der Ladungsspeicherung
20 gewählt, die in diesen Gebieten stattfinden muss, wobei die maximal anzulegende Sperrspannung berücksichtigt wird. Für die anschliessende Entladung der isolierten diskreten Gebiete nach Umkehr der angelegten Spannung hängt dies von dem Vorhandensein von
25 Minoritätsladungsträgern in der Schicht vom ersten

809807/0576

~~9~~
12

PHB.32553
29.6.77
2733840

Leitungstyp zur Neutralisierung der Ladung in den isolierten diskreten Gebieten ab, und es können Massnahmen getroffen werden, um dafür zu sorgen, dass Minoritätsladungsträger vorhanden sind.

- 5 Bei einer bevorzugten Ausführungsform befinden sich wenigstens unter dem durch die Metallschicht kontaktierten Oberflächenteil die diskreten Gebiete vom entgegengesetzten Leitungstyp auf einer nahezu gleichmässigen Tiefe von der genannten Oberfläche.
- 10 Mit Rücksicht auf die Steuerung der Verteilung der Erschöpfungsgebiete, die zu den pn-Übergängen zwischen den isolierten diskreten Gebieten und der Schicht vom ersten Leitungstyp gehören, wenn diese Gebiete maximal aufgeladen werden und die angelegte Spannung
- 15 von der Sperr- zu der Durchlassrichtung geschaltet wird, wobei diese Verteilungsart ist, dass Stromwege zwischen den isolierten diskreten Gebieten nicht völlig gesperrt sind, kann daher die Dotierung der Schicht vom ersten Leitungstyp auf geeignete Weise bestimmt werden.
- 20 So weist in einer anderen bevorzugten Ausführungsform die erste Teilschicht eine höhere Dotierung als die zweite Teilschicht auf. In einer derartigen Anordnung können die Erschöpfungsgebiete, die zu den pn-Übergängen zwischen den isolierten diskreten Gebieten und der
- 25 Schicht vom ersten Leitungstyp gehören, sich beim Aufladen

809807/0578

präferentiell in der zweiten Teilschicht ausbreiten,
während bei anschliessender Umkehr der angelegten
Spannung und vor der Entladung der Erschöpfungsgebiete
die Verteilung der genannten Erschöpfungsgebiete,
5 vorausgesetzt, dass die isolierten diskreten Gebiete
einen geeigneten gegenseitigen Abstand aufweisen,
die Bildung von Stromwegen zwischen den isolierten
diskreten Gebieten ermöglicht. Ausserdem bleiben unter
diesen Bedingungen die Erschöpfungsgebiete gut von der
10 genannten Oberfläche der Schicht vom ersten Leitungstyp
getrennt.

Wenn hier von einer Grenze zwischen der
ersten und der zweiten Teilschicht die Rede ist,
wird damit gemeint, dass der Übergang von der niedrigen
15 dotierten zweiten Teilschicht zu der höher dotierten
ersten Teilschicht nicht abrupt zu sein braucht. In der
Praxis kann, wenn die erste Teilschicht, z.B. durch
epitaktische Ablagerung, auf der zweiten Teilschicht
erzeugt wird, ein Gebiet mit einer allmählich zunehmenden
20 Dotierungskonzentration über eine Dicke von einigen
Mikrons vorhanden sein.

~~Bei einer bevorzugten Ausführungsform,~~
bei der die erste Teilschicht eine höhere Dotierung
als die zweite Teilschicht aufweist, weisen die
25 isolierten diskreten Gebiete vom entgegengesetzt n

-H-
14

PHB.32553
29.6.77

2733840

Leitungstyp einen nahezu gleichmässigen gegenseitigen Abstand auf, während der Abstand zwischen angrenzenden Rändern zweier nebeneinander liegender Gebiete höchstens gleich dem Zweifachen der Dicke der ersten Teilschicht vom ersten Leitungstyp ist. In einer derartigen Anordnung ist die Vergrösserung des Oberflächenfeldes oberhalb des Raumes zwischen nebeneinander liegenden Gebieten beschränkt. Im allgemeinen ist es zu bevorzugen, den genannten Abstand zwischen angrenzenden Rändern zweier nebeneinander liegender Gebiete auf einen Wert zu beschränken, der höchstens gleich der Dicke der ersten Teilschicht ist.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die erste Teilschicht eine niedrigere Dotierung als die zweite Teilschicht auf. Die isolierten diskreten vom entgegengesetzten -----

809807/0576

-12-
-15-
Leitungstyp können einen nahezu gleichmässigen gegen-
seitigen Abstand aufweisen, während der Abstand
zwischen angrenzenden Rändern zweier nebeneinander
liegender Gebiete grösser als das Zweifache der Dicke
5 der ersten Teilschicht vom ersten Leitungstyp sein kann.

Bei den obenbeschriebenen anderen Ausführungs-
formen der Anordnung kann die Struktur derart sein,
dass beim Betrieb, wenn die isolierten diskreten Gebiete
von der angelegten Sperrspannung in derartigem Masse
10 aufgeladen sind, dass, wenn die Sperrspannung herab-
gesetzt wird, wenigstens einige der Erschöpfungsgebiete,
die zu den pn-Übergängen zwischen den isolierten diskreten
Gebieten und der Schicht vom ersten Leitungstyp gehören,
den Schottky-Übergang an der Oberfläche der ersten
15 Teilschicht erreichen. Auf diese Weise können diese
Erschöpfungsgebiete Minoritätsladungsträger entziehen
und dienen daher dazu, das Potential der isolierten
diskreten Gebiete auf den Wert zu beschränken, bei
der die erwähnten Erschöpfungsgebiete den Schottky-
20 Übergang erreichen.

~~Bei einer anderen bevorzugten Ausführungsform~~
kann sich in der Schicht vom ersten Leitungstyp ein
an die Oberfläche grenzendes Gebiet vom entgegen-
gesetzten Leitungstyp rings um den Umfang des durch
25 die Metallschicht kontaktierten Oberflächenteiles befinden,

809807/0576

wobei sich diese Metallschicht in Kontakt mit dem
genannten Gebiet vom entgegengesetzten Leitungstyp
erstreckt. So kann ein sogenannter "Schutzring" vorhanden
sein. Die Injektion von Minoritätsladungsträgern,
5 die einer derartigen Struktur inhärent ist, wird
vorteilhafterweise dazu benutzt, die anfängliche
Entladung der isolierten diskreten Gebiete einzuleiten
und die Stromwege über die Schicht vom ersten Leitungs-
typ zwischen den isolierten diskreten Gebieten zu öffnen.

10 Weitere an die Oberfläche grenzende Gebiete
vom entgegengesetzten Leitungstyp können vorhanden sein
und sich als Bänder rings um den durch die Metallschicht
kontaktierten Oberflächenteil erstrecken. Diese Bänder
können zur weiteren Erhöhung der Sperrdurchschlag-
15 spannung der Anordnung benutzt werden, wobei für eine
vollständige Beschreibung der Theorie der Wirkung
derartiger Bänder, wenn diese in planaren Hochspannungs-
pn-Übergängen verwendet werden, auf den Aufsatz von
Y.C. Kao und E.D. Wolley in "Proc. of I.E.E.E.",
20 Band 55, Nr. 8, August 1967, S. 1409 - 1414 verwiesen
wird.

Einige Ausführungsformen der Erfindung sind
in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden
näher beschrieben. Es zeigen:

809807/0576

- 17 -

2733840

5 Figuren 1 und 2 im Querschnitt bzw. in
Draufsicht einen Teil des Halbleiterkörpers mit der
darauf erzeugten Schicht einer ersten Ausführungsform
einer Halbleiteranordnung nach der Erfindung, wobei
der Querschnitt nach Fig. 1 längs der Linie I-I in
Fig. 2 bezeichnet ist;

10 Figuren 3 und 4 in vergrößertem Massstab
Ansichten eines Teiles des Querschnittes nach Fig. 1
zu zwei verschiedenen Zeitpunkten bei der Herstellung
der Anordnung nach Figuren 1 und 2,

Fig. 5 im Querschnitt einen Teil des
Halbleiterkörpers mit den darauf erzeugten Schichten
einer zweiten Ausführungsform einer Halbleiteranordnung
nach der Erfindung,

15 Figuren 6 und 7 in vergrößertem Masstab
Ansichten eines Teiles des Querschnittes nach Fig. 5
zu zwei verschiedenen Zeitpunkten bei der Herstellung
der Anordnung nach Fig. 5, und

20 Fig. 8 im Querschnitt einen Teil des
Halbleiterkörpers mit der darauf erzeugten Schicht
einer dritten Ausführungsform einer Halbleiteranordnung
nach der Erfindung.

25 Figuren 1 bis 4 zeigen eine Halbleiter-
anordnung mit einer Hochspannungs-Schottky-Diode mit
einer hohen Schaltgeschwindigkeit und einem niedrigen

809807/0576

Durchlassspannungsabfall und einem maximalen Betriebsspannungsbereich von etwa ± 100 V.

Die Anordnung enthält einen Halbleiterkörper aus Silizium mit einem n^+ -Halbleitersubstrat 1 mit einer Dicke von $200 \mu\text{m}$ und einem spezifischen Widerstand von $0,001 \text{ Ohm.cm}$. Auf dem Substrat 1 liegt eine epitaktische Schichtenstruktur, die aus einer unteren n^- -Teilschicht 3 mit einer Dicke von $10 \mu\text{m}$ und einem spezifischen Widerstand von 20 Ohm.cm und einer oberen n -Teilschicht 4 mit einer Dicke von $10 \mu\text{m}$ und einem spezifischen Widerstand von 10 Ohm.cm besteht. Die Teilschicht 4 besitzt eine Oberfläche 5, auf der eine Siliziumoxidschicht 6 mit einer Dicke von etwa 1000 \AA vorhanden ist. Eine kreisförmige Öffnung 7 mit einem Durchmesser von $150 \mu\text{m}$ ist in der Oxidschicht 6 vorgesehen und in dieser Öffnung befindet sich eine Metallschicht 8 aus Nickel mit einer Dicke von 2000 \AA . Die Metallschicht 8 erstreckt sich weiter auf der Oberfläche der Oxidschicht 6 am Rande der Öffnung und weist einen Gesamtdurchmesser von $200 \mu\text{m}$ auf. Die Metallschicht 8 bildet einen gleichrichtenden Metall-Halbleiter-Übergang 9 (einen sogenannten Schottky-Übergang) mit dem kontaktierten Oberflächenteil der n -leitenden Teilschicht 4.

809807/0576

19-

2733840

In der Nähe der Grenze zwischen der n-Teilschicht 3 und der n-Teilschicht 4 befinden sich eine Anzahl in gleichen gegenseitigen Abständen liegender diffundierter p-leitender isolierter diskreter Gebiete 10. Im Querschnitt nach Fig.1 weisen die p-leitenden Gebiete 10 eine Breite von nahezu 7 μm auf, während der Abstand zwischen angrenzenden Rändern zweier nebeneinander liegender Gebiete 10 nahezu 6 μm beträgt. Die Dicke der diffundierten p-leitenden Gebiete 10, die sich teilweise in der Teilschicht 3 und teilweise in der Teilschicht 4 erstrecken, ist nahezu 3 μm . Die p-leitenden Gebiete 10 weisen einen nahezu kreisförmigen Querschnitt (siehe Fig.2) und einen Durchmesser von nahezu 7 μm auf.

Auf der unteren Oberfläche des Substrats 1 liegt eine Metallkontaktschicht 2. Die Kathode der Schottky-Diode wird durch die Schicht 2 und die Anode wird durch die Metallschicht 8 gebildet. Die weiteren Verbindungen mit der Anode und der Kathode sowie die Unterbringung des Halbleiterkörpers in einer Umhüllung werden nicht näher beschrieben, weil sie für die Erfindung nicht von wesentlicher Bedeutung sind.

Die Wirkung der Schottky-Diode, an die eine Wechselspannung angelegt ist, wird nun beschrieben, wobei ausserdem auf Figuren 3 und 4 verwiesen wird.

809807/0576

20 -

2733840

Zunächst sei ein Zeitpunkt während der Halbperiode betrachtet, zu dem der Schottky-Übergang in der Durchlassrichtung geschaltet und die Diode somit leitend ist. Wenn diese Durchlassspannung auf Null herab-

5 gesetzt wird, nimmt der Diodenstrom auf Null ab.

Die Spannung über dem Schottky-Übergang verläuft dann in der Sperrichtung. Bei einer üblichen Schottky-Diode ist die Sperrkennlinie verhältnismässig gleichmässig, weil bei zunehmender Sperrspannung der Strom

10 mit einer Zunahme des angelegten Feldes schnell zunimmt, wie bereits beschrieben wurde. Beim Betrieb der vorliegenden Ausführungsform breitet sich bei zunehmender Sperrspannung das Erschöpfungsgebiet, das zu dem

Schottky-Übergang 9 gehört, von dem genannten Übergang

15 bis in die n-Teilschicht 4 aus, während das Feld ander Oberfläche 5 zunimmt. Endgültig erreicht das Erschöpfungsgebiet die isolierten p-leitenden Gebiete 10 und es

tritt Durchgriff zu den pn-Übergängen zwischen den genannten p-leitenden Gebieten 10 und der n-leitenden

20 Schicht 3,4 auf. An diesem Punkt wird das Oberflächenfeld begrenzt, weil eine weitere Zunahme der Sperrspannung bewirkt, dass die p-leitenden Gebiete 10

aufgeladen werden, wobei die zusätzliche Spannung oberhalb der Durchgriffspannung V_p über den genannten

25 pn-Übergängen herabgesetzt wird. Zum Zeitpunkt, zu dem

809807/0576

COPY

ORIGINAL INSPECTED

die maximale Sperrspannung V erreicht ist, liegen
im Idealfall die isolierten Gebiete 10 an einem
Potential von $V - V_p$, und der Boden des Erschöpfungs-
gebietes nähert sich einem Zustand nahezu gleichmässiger
5 Tiefe in der Teilschicht 3. Fig. 3 zeigt die Ausdehnung
des Erschöpfungsgebietes (mit einer gestrichelten Linie
angegeben), wenn die genannte maximale Sperrspannung
erreicht ist, wobei sich das Erschöpfungsgebiet nahezu
völlig über die Teilschicht auf einer nahezu gleich-
10 mässigen Tiefe erstreckt. Die p-leitenden Gebiete
werden auf diese Weise aufgeladen und, während die
Sperrspannung abnimmt, wird die in den p-leitenden
Gebieten 10 gespeicherte Ladung wiederverteilt, wobei
zu bemerken ist, dass, wenn kein extern angelegtes
15 Feld vorhanden ist, sich die Erschöpfungsgebiete
zwischen den p-leitenden Gebieten 10 und den n-leitenden
Teilschichten 3 und 4 weiter in der niedriger dotierten
Teilschicht 3 als in der höher dotierten Teilschicht 4
erstrecken werden. Fig.4 zeigt eine derartige Situation,
20 in der die angelegte Spannung im Begriff ist, in die
Durchlassrichtung geschaltet zu werden, wobei zu
bemerken ist, dass die Erschöpfungsgebiete, die mit
gestrichelten Linien angegeben sind, die Stromwege
zwischen den einander gegenüber liegenden Seiten der Schicht
25 nicht völlig sperren. So dienen Löcher, die über den

Schottky-Übergang zur Verfügung kommen, wenn die angelegte Spannung in die Durchlassrichtung geschaltet wird, dazu, die p-leitenden Gebiete 10 schnell zu entladen. Die Anzahl von Löchern, die insbesondere von der präzisen Art der Grenzfläche zwischen der Metallschicht 8 und der Halbleiterschicht 4 und von der Art des Metalls abhängig ist, ist, wenn auch klein, normalerweise genügend, um die p-leitenden isolierten diskreten Gebiete zu entladen.

In dieser Ausführungsform dienen die isolierten diskreten Gebiete dazu, das Oberflächenfeld bei zunehmender Sperrvorspannung des Schottky-Übergangs 9 auf einen Wert von weniger als 8×10^4 V/cm, d.h. weniger als ein Drittel des Durchschlagfeldes, zu beschränken. Sie dienen weiter dazu, das Erschöpfungsgebiet an der Oberfläche auszubreiten und das elektrische Feld am Umfang der Diode herabzusetzen.

An Hand der Fig.5 wird nun eine zweite Ausführungsform beschrieben. Diese Anordnung enthält einen Halbleiterkörper aus Silizium mit einem n^+ -Substrat 21 mit einer Dicke von $200 \mu\text{m}$ und einem spezifischen Widerstand von $0,001 \text{ Ohm.cm}$. Auf dem Substrat 21 liegt eine epitaktische Schichtenstruktur, die aus einer unteren n-Teilschicht 23 mit einer Dicke von $15 \mu\text{m}$ und einem spezifischen Widerstand von 2 Ohm.cm und einer

809807/0576

oberen n^- -Teilschicht 24 mit einer Dicke von $4 \mu\text{m}$ und einem spezifischen Widerstand von 5 Ohm.cm besteht. Auf der Oberfläche 25 der Teilschicht 24 befindet sich eine Siliziumoxidschicht 26 mit einer Dicke von 1000 \AA .

5 In einer Öffnung 27 mit einem Durchmesser von $150 \mu\text{m}$ in der Oxidschicht befindet sich eine Metallschicht 28 aus Molybdän mit einer Dicke von 2000 \AA , die einen Schottky-Übergang 29 mit der n^- -Teilschicht 24 bildet. Der Gesamtdurchmesser der Metallschicht 28 ist $200 \mu\text{m}$.

10 In dieser Ausführungsform befinden sich implantierte p-leitende isolierte diskrete Gebiete 30 in der Nähe der Grenze zwischen den Teilschichten 23 und 24. Die Gebiete 30 weisen einen Durchmesser von $8 \mu\text{m}$, einen Teilungsabstand von $18 \mu\text{m}$ (d.h. einen Abstand
15 zwischen angrenzenden Rändern von $10 \mu\text{m}$) und eine Dicke von $3 \mu\text{m}$ auf.

Die Wirkung dieser Ausführungsform, in der der maximale Betriebsspannungsbereich nahezu $\pm 100 \text{ V}$ ist, ist der der vorhergehenden Ausführungsform ähnlich,
20 mit dem Unterschied, dass, weil die spezifischen Widerstandswerte der epitaktischen Teilschichten umgekehrt sind, der Mechanismus zum Entladen der geladenen Gebiete 30 teilweise verschieden ist. Nachdem die Gebiete 30 aufgeladen worden sind und die Sperrspannung von ihrem Höchstwert
25 an abnimmt, dehnen sich die Erschöpfungsgebiete, die zu

809807/0576

den pn-Übergängen zwischen den Gebieten 30 und der Schicht 23, 24 gehören, präferentiell in der Teilschicht 23 und somit zu der Oberfläche 25 hin. Einige der Erschöpfungsgebiete erreichen den Schottky-Übergang 29 und entziehen dadurch Löcher und die Erschöpfungsgebiete bleiben in diesem Zustand, wodurch sie die Spannung der isolierten diskreten Gebiete in bezug auf die der Metallschicht 28 beschränken.

Fig.6 zeigt die Ausdehnung des Erschöpfungsgebietes, das zu dem Schottky-Übergang gehört, wenn die Sperrspannung ihrem Höchstwert aufweist. Das mit einer gestrichelten Linie angegebene Erschöpfungsgebiet erstreckt sich nahezu völlig über die Teilschichten 24 und 23 auf einer nahezu gleichmässigen Tiefe. Die p-leitenden Gebiete werden somit aufgeladen, und zwar im Idealfall bei einem Potential von $V - V_p$, wobei V die maximale Sperrspannung und V_p die Durchschlagspannung von dem Schottky-Übergang 29 zu den Gebieten 30 ist.

Fig.7 zeigt die nachfolgende Situation, in der die angelegte Spannung im Begriff ist, in die Durchlassrichtung geschaltet zu werden, wobei die Erschöpfungsgebiete zwischen den geladenen p-leitenden Gebieten 30 und den Teilschichten 23,24 mit gestrichelten Linien angegeben sind.

809807/0576

Wenn die Spannung in die Durchlassrichtung geschaltet wird, sind die Löcher, die über die Schottky-Sperre zur Verfügung kommen, normalerweise genügend, um die p-leitenden Gebiete 30 zu entladen.

5 In dieser Ausführungsform, wie in der vorhergehenden Ausführungsform, dienen die isolierten diskreten Gebiete dazu, das Oberflächenfeld bei zunehmender Sperrvorspannung auf einen Wert zu beschränken, der kleiner als ein Drittel des Durchschlagfeldes ist. Ausserdem
10 dienen sie dazu, das Erschöpfungsgebiet an der Oberfläche auszubreiten und das elektrische Feld am Umfang der Diode herabzusetzen.

An Hand der Fig.8 wird nun eine dritte Ausführungsform beschrieben. In dieser Ausführungsform,
15 die in bezug auf ihre Struktur eine Abwandlung der ersten Ausführungsform für Betrieb bei höherer Spannung, d.h. mit einem maximalen Betriebsspannungsbereich von nahezu ± 600 V ist, sind entsprechende Gebiete mit den gleichen Bezugswerten bezeichnet. Das n^+ -
20 Substrat 1 weist eine Dicke von $200 \mu\text{m}$ und einen spezifischen Widerstand von $0,001 \text{ Ohm.cm}$ auf. Die untere ~~n^- -Teilschicht 3~~ weist eine Dicke von $60 \mu\text{m}$ und einen spezifischen Widerstand von 20 Ohm.cm auf.
Die obere n-Teilschicht 4 weist eine Dicke von $10 \mu\text{m}$
25 und einen spezifischen Widerstand von 5 Ohm.cm auf.

Die diffundierten isolierten diskreten p^+ -Gebiete 10 weisen einen Durchmesser von 15 μm und einen Abstand zwischen ihren Mittelpunkten von 35 μm (d.h. einen Abstand zwischen angrenzenden Rändern von 20 μm) auf.

In einer Öffnung 7 mit einem Durchmesser von 150 μm in der Isolierschicht 6 liegt eine Metallschicht aus Chrom mit einer Dicke von 2000 Å und diese Metallschicht 8 bildet einen Schottky-Übergang mit der n-Teilschicht 4. Die Metallschicht erstreckt sich weiter auf der Isolierschicht 6 in der Nähe des Randes der Öffnung.

An die Oberfläche der n-Teilschicht 4 unter dem Umfang der Metallschicht 8 grenzt ein diffundierter p^+ -Schutzring 35 mit einer Tiefe von 5 μm . Der Schutzring 35 wird durch die Metallschicht 8 am Rande der Öffnung 7 kontaktiert. Der Schutzring 35 weist einen Innendurchmesser von 120 μm und einen Aussendurchmesser von 180 μm auf. Konzentrisch zu dem Schutzring 35 liegen eine Anzahl diffundierter p^+ -Bänder 36. Die Bänder, die je eine ringförmige Konfiguration aufweisen, haben die gleiche Dotierung wie der Schutzring 35 und sind je 25 μm breit.

Die Wirkung dieser Anordnung ist der der ersten Ausführungsform ähnlich, wobei der p^+ -Schutzring 35

809807/0576

zu der Anzahl vorhandener Löcher durch Injektion beiträgt, um die p^+ -Gebiete 10 zu entladen, wenn die angelegte Spannung in die Durchlassrichtung geschaltet wird. Der Schutzring 35 sowie die Bänder 36 verbessern weiter die Fähigkeit zur Verarbeitung von Sperrspannungen in dieser Anordnung. Die p^+ -Gebiete 10 dienen jedoch dazu, das Oberflächenfeld bei zunehmender Sperrvorspannung auf einen Wert zu begrenzen, der kleiner als ein Drittel des Durchschlagfeldes ist.

Es dürfte einleuchten, dass im Rahmen der Erfindung viele Abwandlungen möglich sind. Insbesondere in bezug auf die Einschränkung der Ausdehnung der Erschöpfungsgebiete, die zu den pn-Übergängen zwischen den isolierten diskreten Gebieten und dem umgebenden Material vom ersten Leitungstyp gehören, kann die Dotierung der Schicht vom ersten Leitungstyp stellenweise in der Nähe der Oberfläche z.B. dadurch geändert werden, dass stellenweise die Dotierung der Oberflächenteile der Schicht, die lokal direkt über den Räumen zwischen den isolierten diskreten Gebieten liegen, vergrößert wird, wobei z.B. eine Maske für die Einführung der erforderlichen Verunreinigungen verwendet wird, die teilweise zu der Maskekomplentär ist, die für die Einführung von Verunreinigungen bei der Bildung der isolierten diskreten Gebiete verwendet wird.

809807/0576

Ausser in Silizium gebildeten Schottky-Dioden können im Rahmen der Erfindung auch Dioden in anderen Halbleitermaterialien, z.B. Galliumarsenid, gebildet werden. Weiter kann ausser bei der Bildung von Anordnungen in Form von Schottky-Dioden für Hochspannungsgleichrichtung die Erfindung auch in anderen einen Schottky-Übergang enthaltenden Anordnungen verwendet werden, z.B. in Anordnungen, in denen der Schottky-Übergang als eine Schutzdiode verwendet wird, oder in Anordnungen, in denen der Schottky-Übergang als eine gesteuerte Stromquelle verwendet wird.

Von der Oberfläche des Körpers her gesehen, auf der der Schottky-Übergang vorhanden ist, können von der Kreisform verschiedene Querschnittsformen für die isolierten diskreten Gebiete verwendet werden; die genannten Gebiete können, von der genannten Oberfläche her gesehen, z.B. einen rechteckigen Querschnitt aufweisen.

In den besonderen beschriebenen Ausführungsformen befinden sich die isolierten diskreten Gebiete in der Anordnung alle auf einer nahezu gleichmässigen Tiefe. Die Erfindung umfasst jedoch auch andere Strukturen, in denen die genannten Gebiete auf verschiedenen Tiefen liegen; z.B. können die unterhalb und jenseits des Umfangs der den Schottky-Übergang

809807/0576

- 79 -

2733840

5 bildenden Metallschicht liegenden Gebiete auf einer
Tiefe liegen, die von der Tiefe verschieden ist,
auf der die genannten isolierten diskreten Gebiete
liegen, die sich direkt unterhalb des Kontakts zwischen
10 der Metallschicht und der Halbleiterkörperoberfläche
befinden. Gleichfalls kann der Abstand zwischen
den isolierten diskreten Gebieten auf entsprechende
oder andere Weise in den genannten Zonen geändert werden.
Auch können eine Anzahl einzelner Schichten isolierter
15 diskreter Gebiete z.B. in einer Anordnung vorhanden sein,
in der eine höhere Durchschlagsspannung erforderlich ist.

In allen besonderen beschriebenen Ausführungs-
formen sind die isolierten diskreten Gebiete derart
angeordnet, dass sie sich über das ganze Gebiet der
15 Grenzfläche zwischen der ersten und der zweiten Teil-
schicht erstrecken. Eine befriedigende Wirkung mit den
inhärenten Vorteilen der Begrenzung des Oberflächen-
feldes kann aber auch noch erhalten werden, wenn die
isolierten diskreten Gebiete lokaler, d.h. wenigstens
20 unter dem Metall-Halbleiter-Übergang, angebracht werden.

Um sicherzustellen, dass der Vorteil der Herabsetzung
des elektrischen Feldes am Umfang der Diode auf be-
friedigende Weise erzielt werden kann, empfiehlt es sich,
dass sich die isolierten diskreten Gebiete lateral
25 jenseits des Aussenrandes des Metall-Halbleiter-Übergangs,
z.B. über einen Abstand von mindestens 50 μm , erstrecken.

809807/0576

-30-
Leers ite

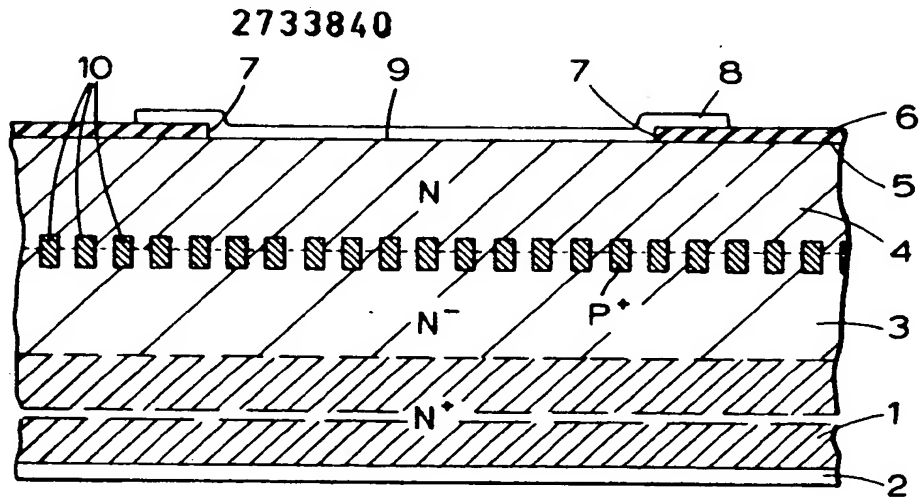


Fig. 1

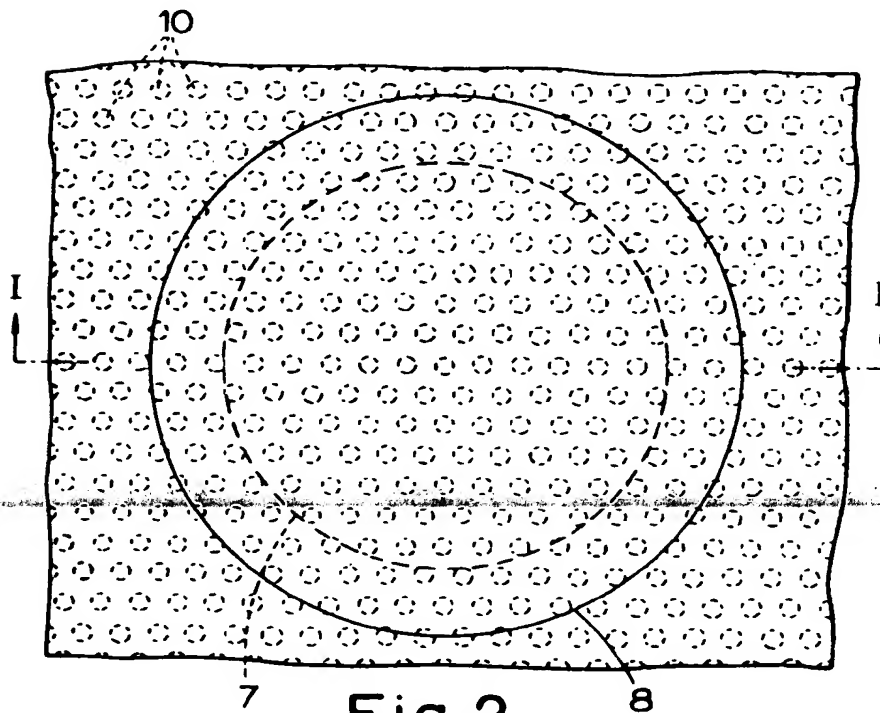


Fig. 2

809807/0578

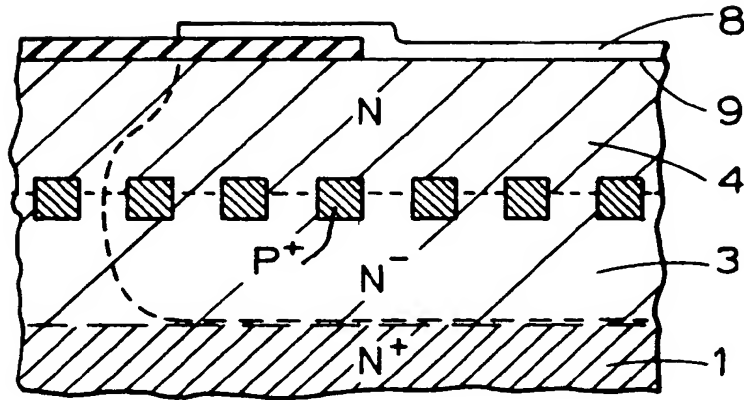


Fig. 3

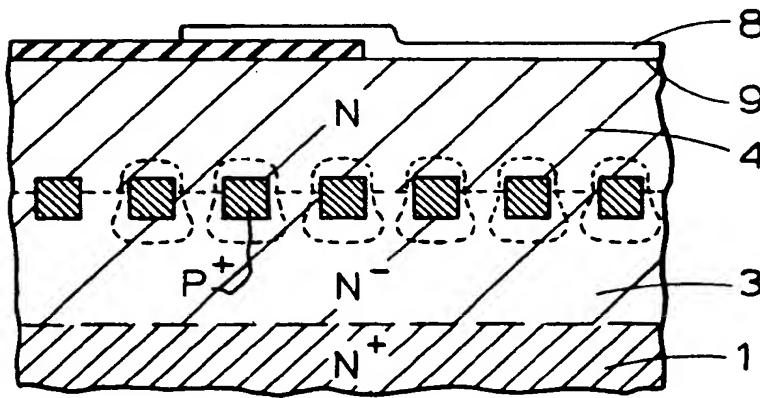


Fig. 4

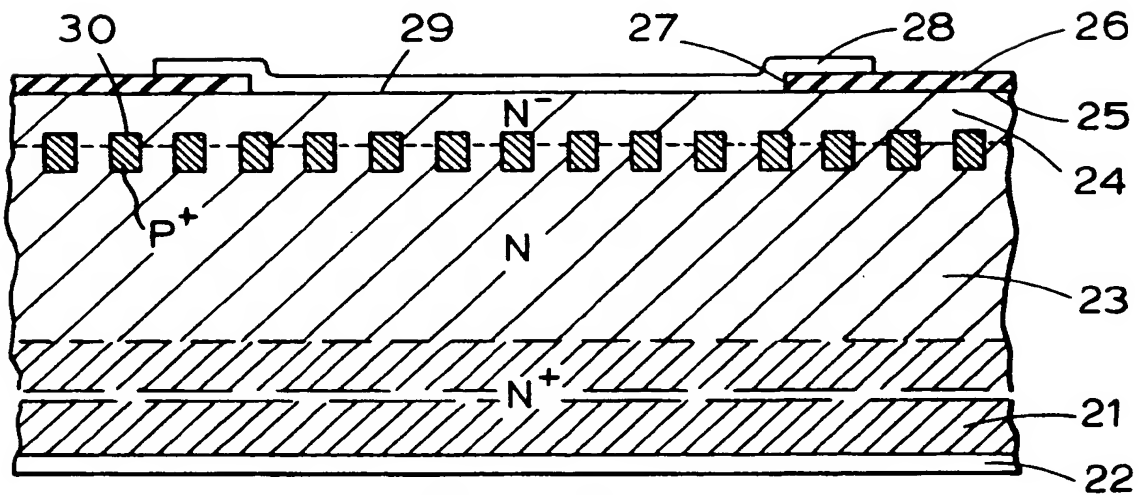
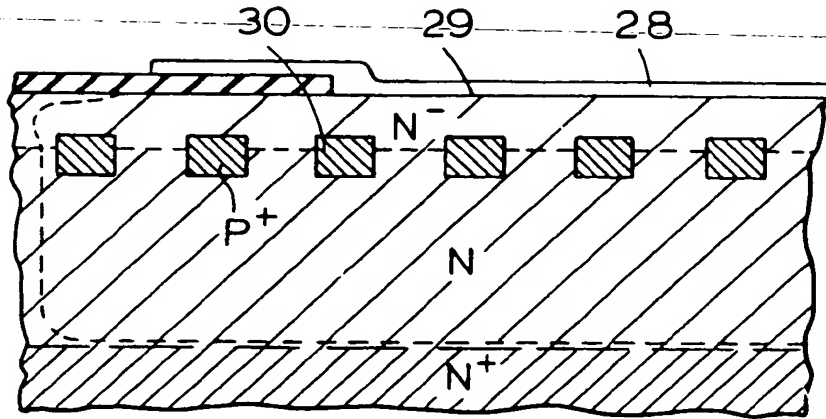


Fig. 5

809807/0576



2733840

Fig. 6

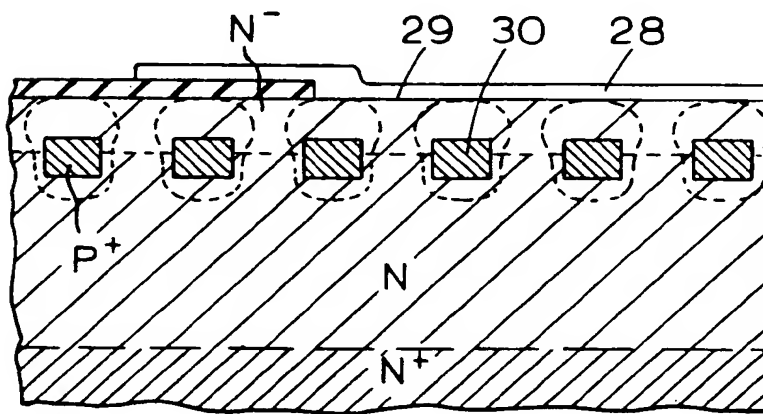


Fig. 7

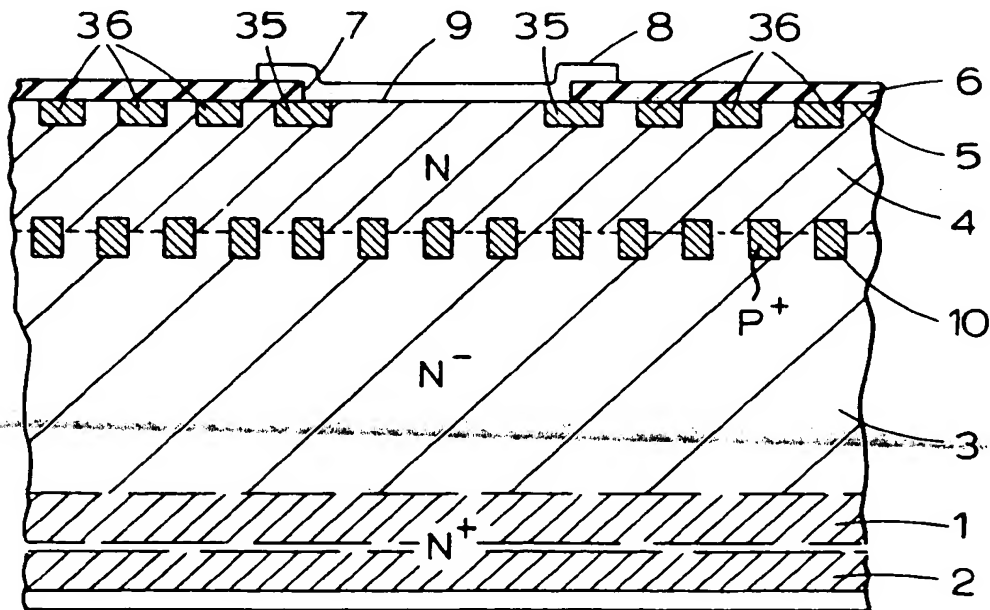


Fig. 8

809807/0576